



افزایش پایداری سلول‌های خورشیدی با استفاده از لایه‌های جاذب پروسکایتی $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3$ آلاینده با برم

مریم عالی‌دائی، مرتضی ایزدی‌فرد*، محمدابراهیم قاضی

دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

(دریافت مقاله: ۹۷/۱/۲۸، نسخه نهایی: ۹۷/۵/۱۴)

چکیده: ترکیب $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3$ یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین ترکیبات پروسکایتی هالیدی بر پایه سرب است که در سلول‌های خورشیدی پروسکایتی استفاده می‌شود. یکی از راه‌های مقابله با مسأله ناپایداری این ساختار پروسکایتی در شرایط معمولی، آرایش برم در این ترکیب است. در این کار، ضمن بررسی ویژگی‌های ساختاری و نوری لایه‌های جاذب $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3$ آلاینده با برم (با نسبت‌های مولی برم به ید $1:0$ ، $3:1$ ، $2:1$ ، $1:1$ ، $1:2$ ، $0:1$) که به روش دومرحله‌ای چرخشی-چرخشی تهیه شدند، پارامترهای فوتولتایی سلول‌های ساخته شده برپایه این لایه‌های جاذب نیز اندازه‌گیری و تحلیل شدند. تغییرات مقادیر پارامترهای فوتولتایی در مدت ۱۶۲ روز از ساخت سلول‌ها به طور مرتب اندازه‌گیری شدند. نتایج بررسی‌ها نشان داد که با وجود اینکه سلول شامل ترکیب پروسکایتی بدون آرایش برم دارای بیشترین بازده اندازه‌گیری شده در روز ساخت ($11/65\%$) است، ولی به مرور زمان دچار افت شدید بازده (86%) می‌گردد. مقایسه نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که کمترین میزان افت بازده (1%) مربوط به سلول دارای لایه جاذب آلاینده با نسبت مولی برم به ید $1:1$ با بازده تبدیل انرژی 9% است.

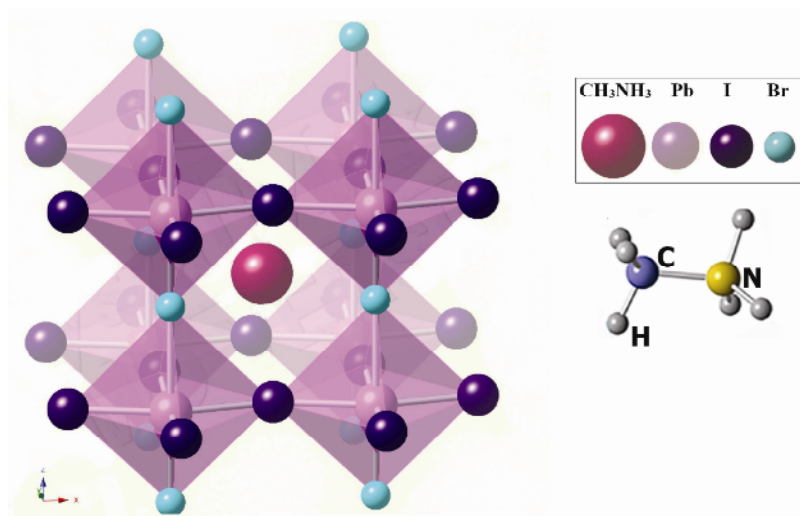
واژه‌های کلیدی: لایه‌های جاذب پروسکایتی؛ لایه‌نشانی دومرحله‌ای چرخشی؛ لایه‌های جاذب $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_{3-x}\text{Br}_x$. پایداری سلول خورشیدی پروسکایتی؛ پروسکایت هالیدی هیبریدی آلی- معدنی؛ بازده تبدیل انرژی.

مقدمه

استفاده از آن‌ها می‌توان سلول‌های خورشیدی با بازده بالا را از فاز محلول و با هزینه کم تولید نمود. بازده سلول خورشیدی تولید شده با کنترل ترکیب این مواد قابل تنظیم است. سلول‌های خورشیدی پروسکایتی به دو دسته مستقیم و معکوس تقسیم می‌شوند. این دو نیز خود به دو ساختار سطح و مزومتخلخل تفکیک می‌شوند [۲-۹]. در این سلول‌ها اغلب لایه پروسکایت روی یک قالب TiO_2 مزومتخلخل لایه‌نشانی می‌شود که جدایی و انتقال الکترون‌ها از طریق این قالب مزومتخلخل انجام می‌پذیرد و لایه‌ی پروسکایتی تنها به‌عنوان یک لایه‌ی جاذب عمل می‌کند. برای انتقال حفره در این

پروسکایت‌های هالیدی هیبریدی آلی- معدنی در چند سال اخیر برای استفاده در ساخت قطعات سلول‌های خورشیدی موضوع پژوهش‌های بسیاری قرار گرفته‌اند. این مواد ترکیباتی با ساختار پروسکایت با فرمول عمومی AMX_3 هستند که در آن X یک یون هالید، M یک یون سرب یا قلع و A یون یک مولکول آلی مانند متیل آمونیوم CH_3NH_3 یا فورم آمیدینیوم $\text{NH}_2(\text{CH})\text{NH}_2$ است (شکل ۱) [۱]. این مواد ویژگی‌های ترکیبات آلی مانند انعطاف‌پذیری بالا و سنتز آسان را به همراه ویژگی‌های خوب ترکیبات معدنی از جمله مقاومت مکانیکی و سختی بالا دارند. مزیت استفاده از این مواد این است که با

*نویسنده مسئول، تلفن: ۰۹۱۲۶۷۳۳۶۰۱، شماره: ۰۲۳۳۲۳۹۵۲۷۰، پست الکترونیکی: mizadifard@shahroodut.ac.ir



شکل ۱ طرح‌واره‌ای از ساختار پروسکایت $\text{MAPbI}_{1-x}\text{Br}_x$.

ناپایداری سلول ممکن است مربوط به تجزیه و یا ناپایداری لایه جاذب پروسکایت و یا دیگر لایه‌های به‌کاررفته در سلول باشد. برای این منظور، گروهی از پژوهشگران فرآیندهای شیمیایی که منجر به تجزیه لایه پروسکایت می‌شوند را به‌تفصیل بررسی و معرفی کرده‌اند [۱۴]. آن‌ها چهار عامل کلیدی دما، رطوبت، تابش فرابنفش (UV) و آثار گرمایی را از عوامل مهم تجزیه پروسکایت‌ها معرفی کرده‌اند. برخی دیگر با به‌کار بردن لایه‌های معدنی انتقال‌دهنده الکترون TiO_2 و حفره $\text{Ni}_x\text{Mg}_{(1-x)}\text{O}$ آلیایده با یون‌های به ترتیب Nb^{5+} و Li^+ و قرار دادن سلول ساخته شده به مدت ۱۰۰۰ ساعت در معرض نور، توانسته‌اند ۹۰٪ از بازده اولیه سلول را حفظ کنند [۱۵]. تأثیر کاربرد این لایه‌های معدنی در سلول، جدایش سریع حامل‌های بار و نیز حفاظت از لایه جاذب پروسکایتی در مقابل تجزیه شدن در مواجهه طولانی مدت با نور است. گروه دیگری از پژوهشگران با استفاده از لایه‌های SnO_2 به‌عنوان لایه انتقال‌دهنده الکترون و نیز باقیمانده PbI_2 تبدیل نشده به ساختار پروسکایت، بین لایه SnO_2 و لایه $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3$ از تجزیه پروسکایت جلوگیری نموده و تنها اتلاف ۱۰٪ را پس از ۷۲۰ ساعت ماندگاری در معرض هوا گزارش کرده‌اند [۱۶]. در پژوهشی دیگر با به‌کارگیری یک ماده انتقال‌دهنده حفره جدید با ویژگی آب-گریزی که از نفوذ آب به سطح پروسکایت جلوگیری می‌کند، به افت بازده کمتر از ۱۰٪ در مدت ۱۰۰۰ ساعت دست یافته‌اند [۱۷]. پژوهشگرانی دیگر با به‌کارگیری ترکیب

سلول‌ها از ماده انتقال‌دهنده حفره پلیمری پلی ۳-هگزیل تیوفن^۱ (P3HT) استفاده می‌شود [۱۰، ۱۱]. ترکیب $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3$ رایج‌ترین ترکیب پروسکایتی است. با ایجاد تغییراتی در این ساختار می‌توان پایداری آن در شرایط محیط را بهبود بخشید. در دهه اخیر برای نخستین بار گزارشی از ساختار هالید پروسکایت به عنوان حساس کننده سلول خورشیدی رنگ‌دانه‌ای به نور ارائه شده است [۱۲]. در این گزارش برای سلول‌های خورشیدی ساخته شده با استفاده از لایه‌های جاذب $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3$ و $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbBr}_3$ به ترتیب بازده‌های ۳/۱۳٪ و ۳/۸۱٪ اعلام شده است. استفاده از برم به دلیل افزایش گاف انرژی از یک سو سبب افزایش ولتاژ مدار باز سلول شده و از سوی دیگر به دلیل قرار نگرفتن بخشی از طیف نور خورشید در گستره‌ی جذب لایه پروسکایتی $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbBr}_3$ جذب نور را کاهش داده و در نتیجه افت قابل توجه جریان و بازده سلول خورشیدی را به همراه دارد. با تغییراتی در ساختار و لایه‌های جاذب به‌کار رفته در سلول‌های خورشیدی پروسکایتی بازده آن‌ها به‌سرعت افزایش یافت تا اینکه در سال گذشته بازده ۲۲/۱٪ برای این سلول‌ها گزارش شد [۱۳].

از جمله چالش‌های سلول‌های خورشیدی پروسکایتی، ناپایداری آنها است. برای رقابت با سایر نسل‌های سلول خورشیدی، رسیدن به سلولی با پایداری بالا بسیار اهمیت دارد.

روش بررسی

لایه‌نشانی لایه‌های پروسکایتی $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3$ خالص و آلاییده با برم

ابتدا ۴۶۲ mg از ماده اولیه PbI_2 (ساخت شرکت شریف سولار با خلوص ۹۹٫۹۹٪) در ۱ ml حلال دی‌متیل‌فرم‌آمید (DMF) ساخت شرکت مرک (خلوص ۹۹٫۹۹٪) حل شد و ۲ ساعت بر همزن مغناطیسی در دمای 90°C هم خورد و محلول به دست آمده با استفاده از صافی سرسرنگی PTFE ($4.5\mu\text{m}$) صاف شد. سپس این محلول بر یک زیرلایه TiO_2 مزومتخلخل به روش چرخشی در دو مرحله پیاپی با سرعت‌های ۳۰۰۰ و ۶۰۰۰ rpm و زمان‌های چرخش ۵ ثانیه لایه‌نشانی شد. خشک‌سازی لایه‌ها نیز بر یک صفحه گرمکن، نخست در دمای 90°C و به مدت ۳ دقیقه و سپس در دمای 100°C برای مدت ۵ دقیقه انجام شد. در ادامه یک مجموعه محلول دیگر شامل دیدیمتیل آمونیوم ($\text{CH}_3\text{NH}_3\text{I}$) سنتز شده توسط این گروه و برمید متیل آمونیوم ($\text{CH}_3\text{NH}_3\text{Br}$) ساخت شرکت شریف سولار (خلوص ۹۹٫۹۹٪) و ایزوپروپانول بدون آب (ساخت شرکت مرک ۹۹٫۹٪) و غلظت ۷ mg/ml با نسبت‌های مولی برم به ید ۱:۰، ۱:۱، ۲:۱، ۳:۱، ۴:۱، ۱:۲ و ۱:۳ تهیه شد. سپس $200\mu\text{l}$ از هر محلول بر یکی از لایه‌های PbI_2 آماده شده ریخته شد و پس از گذشت ۲۰ ثانیه، لایه‌نشانی با سرعت چرخش ۴۰۰۰ دور در دقیقه و به مدت ۲۰ ثانیه انجام شد. سرانجام، لایه‌ها در دمای 100°C به مدت ۵ دقیقه پخت شدند. نمونه‌های تهیه شده با نسبت‌های مولی برم به ید ۱:۰، ۱:۱، ۲:۱، ۳:۱، ۴:۱، ۱:۲ و ۱:۳ به ترتیب با نمادهای S1، S2، S3، S4، S5 و S6 نام‌گذاری شدند.

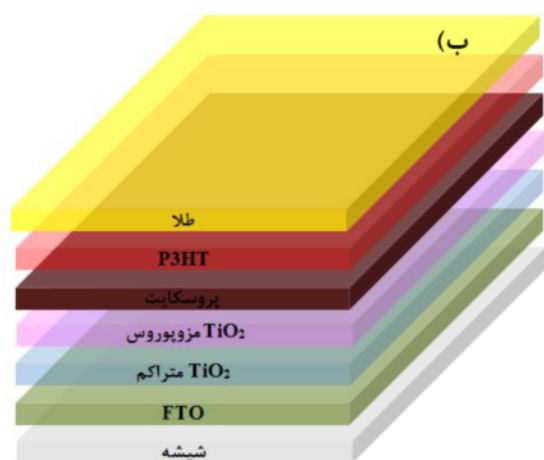
ساخت سلول خورشیدی

برای ساخت سلول خورشیدی مورد نظر، نخست زیرلایه‌های شیشه‌ای پوشش داده شده با FTO (اکسید قلع آلاییده با فلورین) که دارای مقاومت الکتریکی سطحی $25\Omega/\text{sq}$ بودند، توسط پودر روی (Zn) و محلول HCl دو مولار لایه‌برداری (اچ) شدند. سپس با آب دوبار یونیده و صابون شسته شده و به ترتیب در آب و صابون، استون، اتانول و ایزوپروپانول هر یک به مدت ۱۵ دقیقه در حمام فراصوت قرار داده شدند. زیرلایه‌ها پس از شستشو و خشک‌سازی، به مدت ۱۵ دقیقه زیر تابش پرتوی UV قرار گرفتند تا باقیمانده مواد آلی از سطح آن‌ها زدوده شوند. برای لایه‌نشانی لایه انتقال‌دهنده الکترون TiO_2

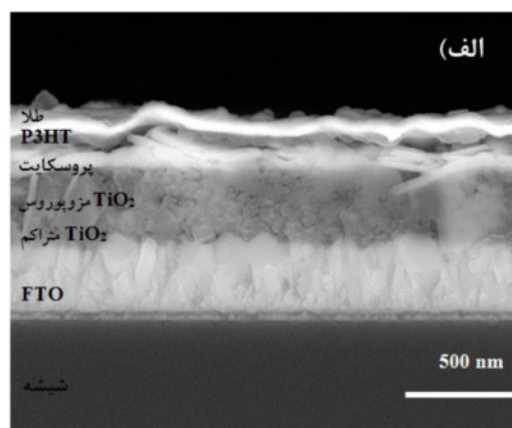
به جای $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3$ در سلول خورشیدی ساخته شده تنها ۱۰٪ اتلاف بازده پس از گذشت ۶۰ روز را گزارش کردند [۱۸]. همچنین دستیابی به پایداری رطوبتی بهتر با استفاده از وارد کردن فنیل متیل آمونیوم ($\text{C}_6\text{H}_5(\text{CH}_2)_2\text{NH}_3^+$) در زمینه پروسکایت $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3$ و تشکیل پروسکایت دوبعدی گزارش شده است [۱۹]. اگرچه این سلول خورشیدی به راحتی در شرایط محیط ساخته شد اما بازده رضایت‌بخشی نداشت. پژوهشگران نشان دادند که با آلیش برم در ترکیب پروسکایت، پایداری سلول خورشیدی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد [۲۰]. این افزایش پایداری با افزایش مقدار برم، به کاهش ثابت شبکه و گذار از فاز چارگوشی به مکعبی نسبت داده شده است. پژوهشگران در تلاش برای جایگزین کردن عنصر سمی سرب با قلع، با مشکل ناپایداری شدید و اکسایش یون Sn^{2+} روبرو شدند که به نظر می‌رسد که این مشکل با آلیش برم تاحدی جبران می‌شود [۲۱]. برخی از ترکیب پروسکایتی جدید بدون سرب $\text{Cs}_3\text{Sb}_2\text{I}_9$ به عنوان لایه جاذب سلول خورشیدی استفاده کردند [۲۲]. در طیف پراش پرتوی ایکس (XRD) این لایه پس از گذشت ۶۰ روز، علاوه بر قله‌های مربوط به ترکیب $\text{Cs}_3\text{Sb}_2\text{I}_9$ یک قله پراش ضعیف مربوط به تشکیل فاز ناخالصی CsI نیز دیده شد که با توجه به استفاده از پیش ماده اولیه CsI برای تهیه این لایه‌ها و چگونگی تهیه آنها، حضور آن به تجزیه ساختار به پیش ماده خود نسبت داده شد. در این پژوهش همچنین افزایش پایداری به ساختار بلوری معدنی این ترکیب و یا ساختار دانه‌ای آن نسبت داده شد.

چنان که اشاره شد نتایج پژوهش‌های پیرامون لایه‌های جاذب پروسکایتی در سلول‌های خورشیدی نشان می‌دهد که آلیش یون برم در لایه پروسکایتی می‌تواند منجر به افزایش پایداری ذاتی آن‌ها شود. بنابراین با توجه به اهمیت کیفیت لایه جاذب در افزایش جذب نور و انتقال الکترون‌ها و حفره‌ها به لایه انتقال‌دهنده الکترون و حفره و همچنین بازده و پایداری سلول خورشیدی، در این کار به بررسی تأثیر آلیش برم بر ویژگی‌های فیزیکی لایه‌های جاذب پروسکایتی $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3$ ساخته شده به روش دومرحله‌ای چرخشی-چرخشی به منظور بهبود بازده سلول‌های خورشیدی ساخته شده بر پایه آن‌ها پرداخته شده است.

تراکم‌های اشاره شده در بخش ۲-۱ روی آن نهشته شد. برای تهیه لایه انتقال‌دهنده حفره، محلولی از پلیمر P3HT حل‌شده در کلروبنزن بدون آب با غلظت ۱۰ mg/ml بر لایه پروسکایت با سرعت ۲۰۰۰ rpm به مدت ۴۵ ثانیه لایه‌نشانی شد. برای بهبود بلورینگی لایه P3HT آنها در دمای 120°C به مدت ۵ دقیقه در محفظه پر شده از گاز نیتروژن نیز پخت شد. سرانجام جهت اتصال الکتریکی، یک لایه نازک از طلا به روش تبخیر حرارتی در خلأ با استفاده از یک الگو بر زیرلایه لایه‌نشانی شد. طرح‌واره‌ای از سلول‌های خورشیدی پروسکایتی مزومتخلخل ساخته‌شده در شکل ۲ ب و همچنین تصویر SEM از مقطع عرضی یک سلول نوعی در شکل ۲ الف نشان داده شده است. مشخصه‌یابی ساختاری لایه‌های جاذب پروسکایتی سنتز شده با استفاده از یک پراش‌سنج پرتو X (Bruker, AXS)، با پرتوی کبالت با طول‌موج $K_{\alpha}=1.789 \text{ \AA}$ انجام شد. ریختار و زبری سطح لایه‌ها نیز با استفاده از یک میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدان (FESEM: HITACHI S-4160) و یک میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM: VeecoPCResearch) بررسی شدند. ویژگی‌های نوری لایه‌ها با استفاده از یک طیف-سنج مرئی-فرابنفش (UV-Vis: Shimadzu 1800) بررسی شدند. مشخصه فوتولتایی سلول خورشیدی ساخته‌شده با استفاده از یک پتانسیواستات (XRE, Ivium) و یک دستگاه شبیه‌ساز سلول خورشیدی واسنجی شده AM 1.5 با شدت 100 mW/cm^2 (Sharif Solar 10-2) ساخت ایران بررسی شدند.



محلولی از تیتانیم تترا ایزوپروپوکساید (TTIP)، HCl و اتانول بدون آب (ساخت شرکت مرک با خلوص بیش از ۹۹/۹٪) تهیه شده و با سرعت چرخش ۲۰۰۰ rpm و به مدت ۳۰ ثانیه بر زیرلایه FTO لایه‌نشانی شد و بلافاصله قسمتی از آن برای الکتروگذار با طلا پاک شد. سپس لایه‌ها درون یک کوره الکتریکی در دمای 500°C به مدت ۳۰ دقیقه پخت شدند. پس از آن، لایه‌ها در محلول TiCl_4 (۴۰ mM) در آب دو بار (یونیده) به مدت نیم ساعت در یک کوره الکتریکی آزمایشگاهی در دمای 70°C قرار داده شده و سپس با آب دوبار یونیده شستشو داده شده و در کوره خشک‌سازی و سپس در یک کوره‌ای در دمای 500°C به مدت ۳۰ دقیقه بازپخت شدند. برای تهیه لایه مزومتخلخل TiO_2 ، محلولی از خمیر نانوذرات TiO_2 (با اندازه ذره حدود ۲۰ نانومتر ساخت شرکت شریف سولار) رقیق‌شده در اتانول بدون آب به نسبت وزنی ۱:۳/۵ تهیه گردید و بر لایه‌های پیشتر تهیه‌شده قبلی با سرعت چرخش ۵۰۰۰ rpm به مدت ۲۰ ثانیه لایه‌نشانی شده و بلافاصله روی صفحه داغ 70°C به مدت ۳۰ دقیقه خشک شد. با کنترل شرایط لایه‌نشانی چرخشی و غلظت پیش‌ماده‌های مورد استفاده، یک لایه TiO_2 با ضخامت ۴۰۰ nm تهیه گردید. لایه‌ها پس از خشک‌سازی، درون یک کوره بازپخت شدند. سپس مرحله غوطه‌وری لایه‌ها در محلول TiCl_4 و گرمادهی آنها در یک کوره آزمایشگاهی در دمای 70°C به مدت نیم ساعت و بازپخت دوباره در کوره تکرار شد. پس از تهیه لایه مزومتخلخل TiO_2 ، لایه پروسکایت خالص و آلییده با برم با



شکل ۲ الف- یک تصویر SEM نوعی از مقطع عرضی سلول خورشیدی ساخته‌شده و ب- طرح‌واره‌ای از سلول خورشیدی پروسکایتی مزومتخلخل ساخته‌شده در این پژوهش.

بحث و بررسی

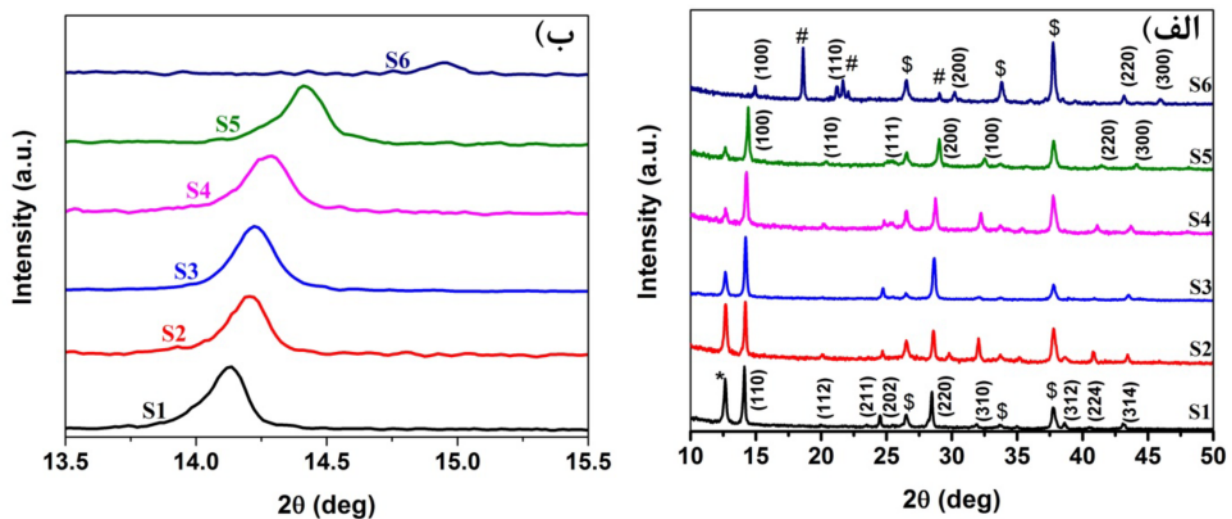
طرح‌های پراش پرتو X ثبت‌شده برای لایه‌های پروسکایت تهیه شده در شکل ۳ نشان داده شده است. در الگوی XRD نمونه‌های S1 و S2 (نمونه‌های بدون برم و با آلایش بسیار کم برم) قله‌های پراش از صفحات (۱۱۰)، (۱۱۲)، (۲۱۱)، (۲۰۲)، (۲۲۰)، (۳۱۰) و (۳۱۲)، (۲۲۴) و (۳۱۴) مربوط به تشکیل ساختار پروسکایتی چارگوشی $CH_3NH_3PbI_3$ ظاهر شده‌اند [۲۰، ۲۳]. قله ظاهرشده در زاویه حدود 14.5° مربوط به ترکیب PbI_2 باقیمانده و تبدیل نشده به ساختار پروسکایت در لایه است. چنان که در شکل ۳ ب دیده می‌شود با افزایش مقدار برم در لایه‌ها، قله اصلی (۱۱۰) ساختار پروسکایت به دلیل تغییر پارامترهای ساختاری شبکه به سمت زوایای بزرگتر جا به جا می‌شود که با گزارش‌های پیشین همخوانی دارد [۲۰]. قله‌های ظاهرشده در الگوی XRD نمونه‌های S3-S6 (دارای یون برم) تأییدکننده تشکیل ساختار پروسکایت با فاز مکعبی است [۲۰، ۲۴، ۲۵]. اندازه متوسط بلورکها (D) با استفاده از رابطه ویلیامسون- هال (۱) برآورد شد:

$$\beta \cos \theta = \frac{k\lambda}{D} + 4\epsilon \sin \theta \quad (1)$$

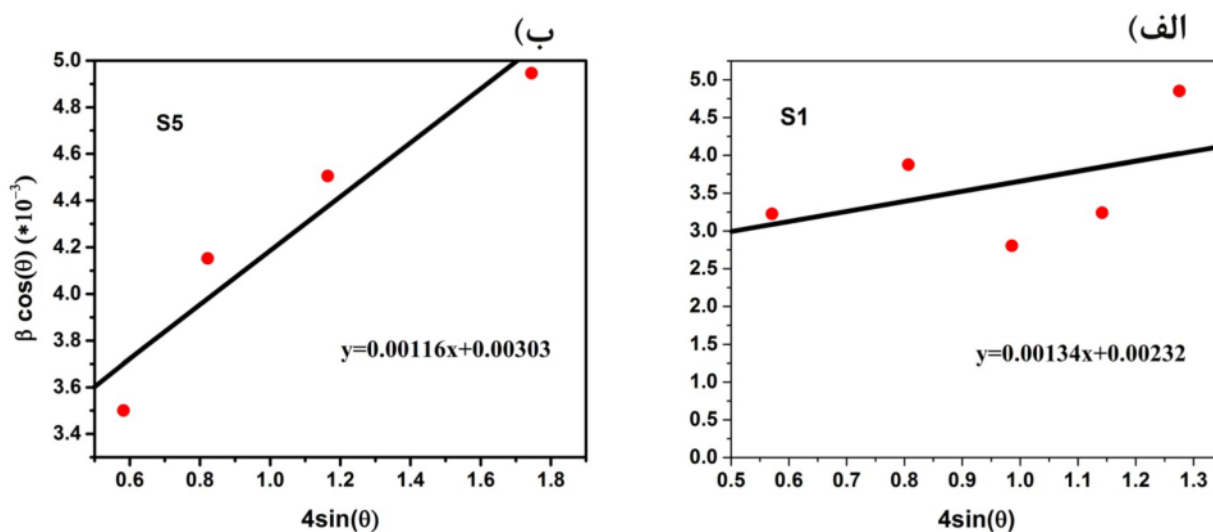
در این رابطه β نیم‌پهنا در نصف ارتفاع بیشینه قله پراش، θ زاویه پراش، λ طول موج پرتوایکس و ϵ کرنش میکروسکوپی

است. به عنوان مثال، نمودار ویلیامسون- هال نوعی مربوط به نمونه‌های S1 و S5 (به ترتیب فازهای چارگوشی و مکعبی) در شکل ۴ نشان داده شده است. برای رسم نمودارها از پنج قله شدیدتر (۱۱۰)، (۱۱۲)، (۲۰۲)، (۲۲۰) و (۳۱۰) در نمونه‌های S1 و S2 و قله‌های (۱۰۰)، (۱۱۱)، (۲۰۰) و (۳۰۰) در نمونه S3 و قله‌های (۱۰۰)، (۱۱۰)، (۲۰۰) و (۲۲۰) برای نمونه‌های S4، S5 و S6 استفاده شده است. اندازه بلورک‌های به‌دست‌آمده به این ترتیب در جدول ۱ گزارش شده است. مقایسه ابعاد بلورک‌ها نشان می‌دهد که با افزایش غلظت مولی برم در صورت ثابت ماندن غلظت مولی ید (نمونه‌های S4 و S5)، اندازه بلورک‌ها افزایش می‌یابد. اندازه متوسط بلورک‌های نمونه‌های S2 و S3 از سایر نمونه‌ها بیشتر هستند. کاهش چگالی مرزخانه‌ها با افزایش اندازه بلورک‌ها در لایه جاذب پروسکایتی می‌تواند باعث کاهش میزان بازترکیب الکترون‌ها و حفره‌ها شود که امری مطلوب برای عملکرد بهتر سلول خورشیدی است. پارامترهای شبکه (a,c) و حجم یاخته یک لایه‌های پروسکایت با استفاده از روابط زیر داده‌های وابسته به قله‌های پراش اصلی (۱۱۰) و (۱۰۰) به ترتیب برای ساختارهای چارگوشی و مکعبی به‌دست‌آمدند:

$$n\lambda = 2d_{hkl} \sin \theta \quad (2)$$



شکل ۳ الف- الگوی XRD لایه‌های جاذب $MAPbI_{1-x}Br_x$ با نسبت‌های مولی برم به ید مختلف، ب- نمایش قله (۱۱۰) در گستره زاویه‌ای بزرگ‌شده برای مشاهده بهتر جابه‌جایی این قله. قله‌های دارای علامت مربع (#) و ستاره (x) به ترتیب مربوط به فازهای ثانویه PbI_2 و $PbBr_2$ و قله‌های دارای علامت \$ متعلق به زیرلایه FTO هستند.



شکل ۴ نمودارهای ویلیامسون- هال مربوط به نمونه های: الف- S1 و ب- S5.

جدول ۱ مشخصه‌های ساختاری به دست آمده از بررسی الگوی XRD لایه‌های جاذب نمونه‌های S1, S2, S3, S4, S5, S6.

نمونه	نسبت مولی (I:Br)	اندازه بلورک (nm)	سیستم بلوری	کرنش ($\times 10^{-3}$)	پارامترهای شبکه (Å)		حجم یاخته یکه (Å ³)
					a=b	c	
S1	۱:۰	۶۹,۴۰	چارگوشی	۱,۳۴	۸,۸۶۳	۱۲,۶۵۴	۹۹۴,۰۰۷
S2	۳:۱	۷۵,۲۴		۱,۰۵	۸,۸۱۶	۱۲,۳۰۷	۹۵۶,۵۲۴
S3	۲:۱	۷۷,۷۸	مکعبی	۱,۱۸	۶,۲۱۹		۲۴۰,۵۰۳
S4	۱:۱	۴۸,۳۵		۱,۰۷	۶,۲۰۰		۲۳۸,۳۴۹
S5	۱:۲	۵۳,۱۴		۱,۱۶	۶,۱۴۱		۲۳۱,۶۳۱
S6	۰:۱	۶۸,۲۲		۱,۰۳	۵,۹۲۳		۲۰۷,۸۳۵

به دست آمده در جدول ۱ گزارش شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که با افزایش مقدار برم در ترکیب، پارامتر شبکه و در نتیجه حجم یاخته یکه کاهش یافته است. کاهش پارامترهای شبکه را می‌توان به کوچک‌تر بودن شعاع یونی ید 196 \AA نسبت به برم 212 \AA نسبت داد. کرنش میکروسکوپی در نمونه‌ها تغییر قابل توجهی ندارد. نمونه‌های S1 و S6 به ترتیب دارای بیشترین و کمترین کرنش در شبکه بلوری خود هستند. برای بررسی ریختاری لایه‌های جاذب پروسکایت خالص $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3$ و آلاییده با برم تصاویر SEM از سطح آن‌ها ثبت شد که این تصاویر در شکل ۵ نشان داده شده است. دیده می‌شود که با حضور برم، لایه‌ها متراکم‌تر شده و دانه‌بندی در آن‌ها به‌طور کلی تغییر می‌کند. شکل غالب دانه‌ها در نمونه‌های برم‌دار S2 و S3 و S5 تقریباً مکعبی است. در نمونه S4 (با نسبت مولی ۱:۱) دانه‌ها ریزتر و خلل و فرج در سطح کمتر

که در آن n مرتبه پراش، λ طول موج پرتوی X ، d_{hkl} فاصله صفحات بلوری هم‌خانواده و θ زاویه براگ است.

$$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{(h^2 + k^2)}{a^2} + \frac{l^2}{c^2} \quad (3)$$

$$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{(h^2 + k^2 + l^2)}{a^2} \quad (4)$$

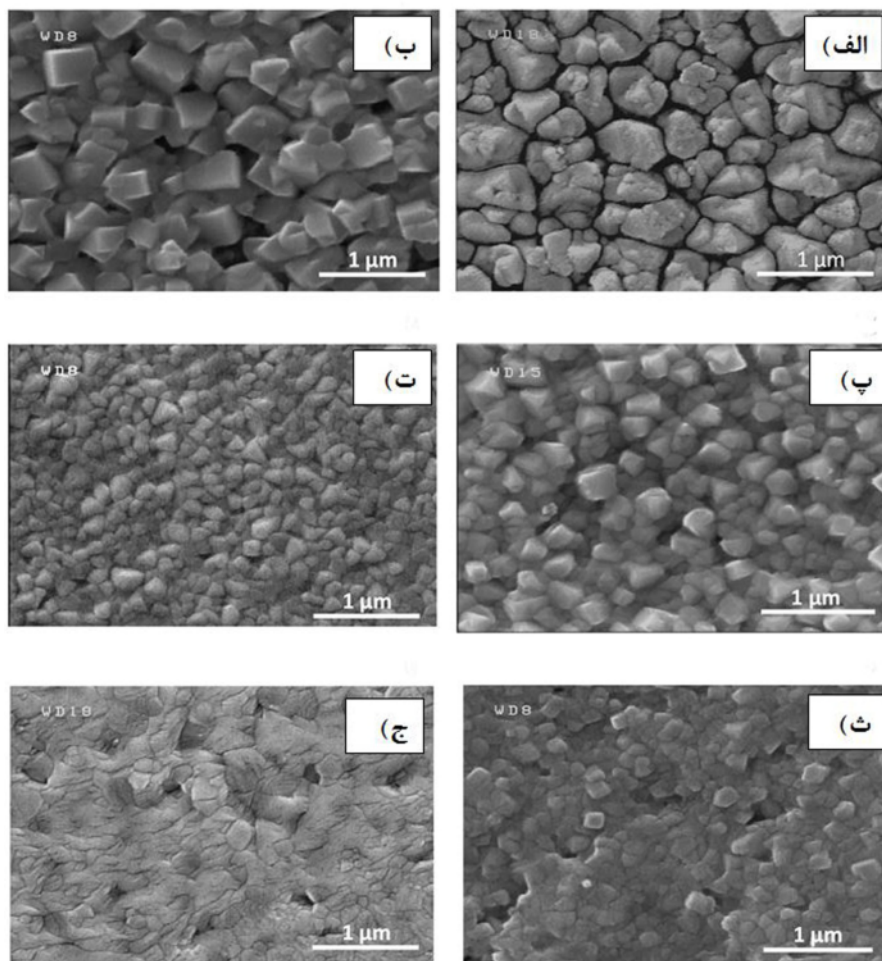
$$V = a^2 \times c \quad (5)$$

$$V = a^3 \quad (6)$$

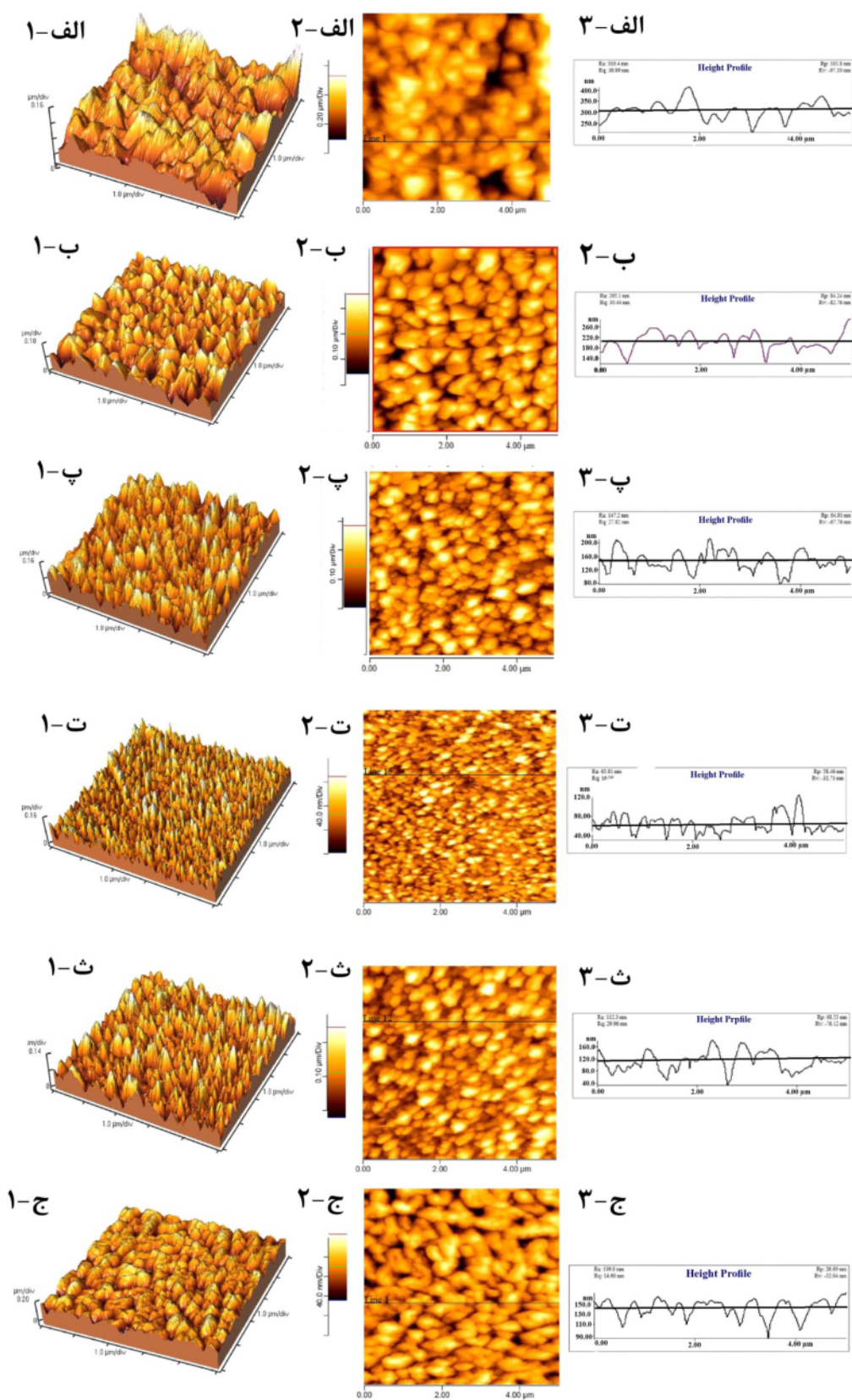
روابط (۳) و (۵) برای محاسبه پارامترهای شبکه ساختار چارگوشی و روابط (۴) و (۶) نیز برای محاسبه پارامترهای شبکه ساختار مکعبی استفاده می‌شوند. پارامترهای ساختاری

شد. ریشه میانگین مربعی (RMS) زبری سطح در ابعاد $5\mu\text{m} \times 5\mu\text{m}$ با استفاده از تصاویر AFM و نرم‌افزار ProScan محاسبه شد. تصاویر سه و دو بعدی و همچنین نیمرخ تغییر زبری سطح لایه‌ها در شکل ۶ نشان داده شده است. نتایج این بررسی نشان داد که مقدار RMS لایه‌ها از مقدار 36.99 nm برای نمونه S1 (نمونه بدون آرایش برم) 14.6 nm برای نمونه S6 (نمونه $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3$) بدون ید $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbBr}_3$ کاهش یافته است. زبری سطح لایه S4 (16.97 nm) نیز در مقایسه با سایر نمونه‌ها کمتر است. مقادیر RMS به دست آمده برای لایه‌ها در جدول ۲ گزارش شده است. مقایسه این نتایج نشان می‌دهد که ورود برم به نمونه (تا نمونه S4) ابتدا باعث کاهش قابل توجه زبری سطح و یکنواختی آن می‌شود، اما با افزایش آن (نمونه S5) زبری باز افزایش می‌یابد.

شده‌اند و ساختار لایه را ترکیبی از دانه‌های بیشتر کروی و مکعبی تشکیل می‌دهند. نمونه‌های با نسبت‌های مولی برم به ید $1:0$ (S1) و $1:1$ (S4) به ترتیب دارای بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین اندازه دانه هستند. چنانکه در شکل‌های ۴ الف و ت دیده می‌شود با افزایش برم به ید $1:0$ تا نسبت مولی $1:1$ (نمونه‌های S1 و S4) اندازه دانه‌ها کاهش یافته است. سپس با افزایش بیشتر برم (نمونه S5) اندازه دانه‌ها باز کمی افزایش یافته است و شاهد در هم فرورفتگی دانه‌های تقریباً مکعبی هستیم. دانه بندی برای نمونه S6 که تنها شامل برم است، به طور کلی متفاوت از سایر نمونه‌ها بوده و حضور حفره‌هایی روی سطح لایه مشهود است. مقایسه تصاویر SEM نمونه‌های با نسبت مولی برم ثابت و ید متفاوت (نمونه‌های S2 و S3 و S4) نشان می‌دهد که با غالب شدن اثر نسبت مولی برم ابعاد دانه‌ها ریزتر ولی توزیع آنها یکنواخت‌تر شده است. برای بررسی زبری سطوح لایه‌های جاذب پروسکائیتی تصاویر AFM از سطح آنها تهیه



شکل ۵ تصاویر SEM ثبت شده از سطح لایه‌های جاذب پروسکائیتی الف- نمونه S1، ب- نمونه S2، پ- نمونه S3، ت- نمونه S4، ث- نمونه S5، و ج- نمونه S6.



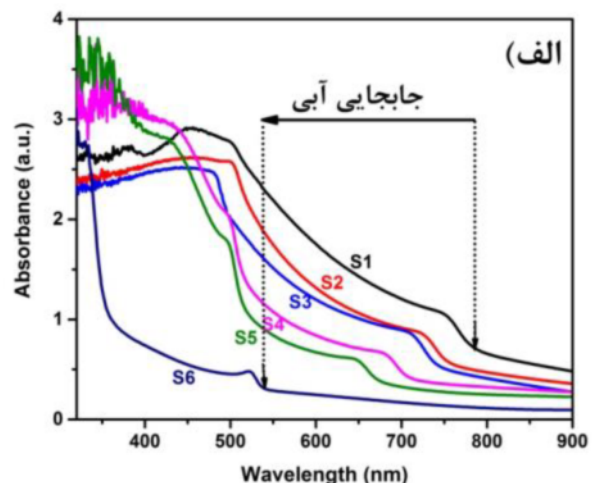
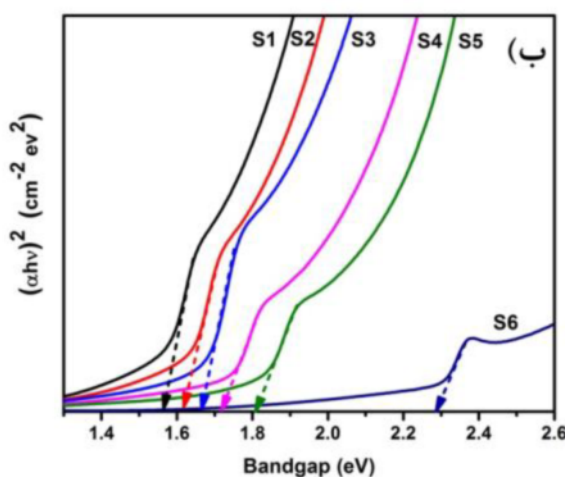
شکل ۶ تصاویر AFM به ترتیب از راست به چپ نیمرخ (۱)، دوبعدی (۲) و سه‌بعدی (۳) ثبت‌شده از سطح لایه‌های جاذب پروسکایتی: الف- S1، ب- S2، پ- S3، ت- S4، ث- S5، ج- S6.

فرودی ($h\nu$) و برون‌یابی قسمت خطی این منحنی با محور انرژی، گاف نواری مستقیم لایه‌های پروسکایت برآورد شد (شکل ۷ ب). مقادیر گاف نواری نمونه‌ها در جدول ۲ گزارش شده است. مقایسه گاف نواری نمونه‌ها نشان می‌دهد که با افزایش مقدار برم در ترکیب پروسکایت هالیدی، گاف نواری افزایش و بر عکس با افزایش مقدار ید، گاف نواری کاهش می‌یابد. مقادیر گاف انرژی به‌دست‌آمده با گزارش دیگران همخوانی دارد [۲، ۲۰، ۲۷، ۲۸]. با افزایش نسبی مقدار برم در لایه‌های پروسکایت امکان تشکیل ترازهای جدید انرژی در بالای لبه نوار رسانش و یا پایین لبه ظرفیت فراهم شده و به‌این‌ترتیب موجب یک جابجایی آبی در لبه جذب ذاتی و در نتیجه افزایش گاف انرژی می‌شود. این پهن‌شدگی ترازهای انرژی در لبه جذب می‌تواند منجر به افزایش ولتاژ مدار باز (V_{oc}) سلول خورشیدی گردد [۲۹، ۳۰].

برای بررسی ویژگی‌های نوری لایه‌ها، طیف جذب (A) آن‌ها نسبت به طول‌موج فوتون فرودی اندازه‌گیری شد. نتایج این اندازه‌گیری در شکل ۷ الف نشان داده شده است. مقایسه طیف‌های جذب نشان می‌دهد که نمونه بدون برم S1 دارای بیشترین میزان جذب و نمونه بدون ید ($CH_3NH_3PbI_3$) S6 دارای کمترین میزان جذب هستند. همچنین چنانکه در شکل ۷ دیده می‌شود با افزایش نسبی مقدار برم در لایه‌ها، لبه جذب ذاتی به دلیل افزایش گاف نواری از طول‌موج حدود ۷۹۰ nm در نمونه S1 به حدود ۵۴۰ nm در نمونه S6 جابه‌جاشده است (جابه‌جایی آبی). برای محاسبه گاف نواری مستقیم نمونه‌ها از رابطه تائوک استفاده شد [۲۶]:

$$Ah\nu = a(h\nu - E_g)^{\frac{1}{2}} \quad (7)$$

که در آن h ثابت پلانک، ν بسامد فوتون فرودی و a یک مقدار ثابت است. با رسم منحنی $(Ah\nu)^2$ برحسب انرژی فوتون



شکل ۷ الف - طیف‌های جذب و ب - نمودارهای تائوک برای محاسبه گاف انرژی نمونه‌های مختلف.

جدول ۲ داده‌های برآمده از بررسی تصاویر AFM لایه‌های جاذب پروسکایتی و اندازه‌گیری پارامترهای فوتولتایی سلول‌های خورشیدی برپایه این لایه‌های جاذب.

نمونه (نسبت مولی I:Br)	E_g (eV)	RMS (nm)	PCE (%)	J_{sc} (mA/cm^2)	V_{oc} (V)	FF (%)	افت بازده سلول در مدت ۱۶۲ روز (%)
S1 (۱:۰)	۱٫۵۵۶	۳۶٫۹۹	۱٫۶۵	۲۰٫۵۷	۰٫۹۲	۶۲	۸۶
S2 (۳:۱)	۱٫۶۲۷	۳۰٫۴۴	۱۰٫۰۱	۱۸٫۵۲	۰٫۹۴	۵۸	۳۶
S3 (۲:۱)	۱٫۶۵۸	۲۷٫۸۲	۱۰٫۴۸	۱۶٫۹۳	۰٫۹۸	۶۴	۴۰
S4 (۱:۱)	۱٫۷۲۲	۱۶٫۹۷	۹٫۰۰	۱۳٫۳	۱٫۰۳	۶۶	۱
S5 (۱:۲)	۱٫۸۱۰	۲۹٫۹۶	۷٫۷۶	۱۰٫۱۹	۱٫۱۱	۶۹	۲۷
S6 (۰:۱)	۲٫۲۹۰	۱۴٫۶۰	-	-	-	-	-

به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که بیشترین (V_{oc} ۱/۱۱) و کمترین (V_{oc} ۰/۹۲) مقدار V_{oc} به ترتیب مربوط به سلول‌های ساخته‌شده با لایه‌های جاذب پروسکایت S5 (با نسبت مولی برم به یُد ۱:۲) و S1 (لایه بدون برم) است. همچنین بیشترین (J_{sc} ۲۰/۵۷) و کمترین (J_{sc} ۱۰/۱۹) مقدار J_{sc} به ترتیب مربوط به سلول‌های ساخته‌شده با نمونه‌های S1 و S5 است. عامل پوشاندگی (FF) سلول‌ها با استفاده از رابطه زیر به دست آمد [۳۳]:

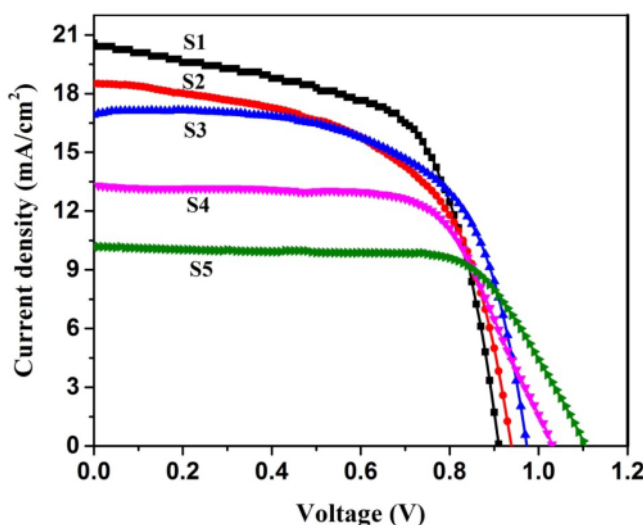
$$FF = \frac{V_{max} \times J_{max}}{V_{oc} \times J_{sc}} \quad (8)$$

در این رابطه V_{max} و J_{max} به ترتیب بیشینه ولتاژ و چگالی جریان، V_{oc} ولتاژ مدارباز و J_{sc} چگالی جریان اتصال کوتاه سلول است. مقادیر FF به‌دست‌آمده در جدول ۲ گزارش شده است. با توجه به نتایج به‌دست آمده، بیشترین (۰/۶۹) و کمترین (۰/۵۸) مقدار FF مربوط به سلول‌های ساخته‌شده با لایه‌های جاذب پروسکایتی S5 (دارای بیشترین غلظت مولی برم) و S2 (با کمترین غلظت مولی برم) است. علت افزایش FF در سلول‌های دارای برم بیشتر ممکن است به پوشش بهتر سطح لایه جاذب پروسکایتی و کاهش خلل و فرج و زبری سطح که موجب کاهش مسیرهای اتصال‌دهنده لایه انتقال-دهنده الکترون و حفره می‌شود مربوط باشد [۲۹]. بازده تبدیل انرژی سلول‌ها (PCE) از رابطه زیر به‌دست آمد [۳۳]:

$$PCE(\%) = \frac{V_{max} \times J_{max}}{P_{in}} \times 100 \quad (9)$$

چنان که از تصاویر SEM و AFM مشخص شد با افزایش مقدار برم در لایه‌ها، یکنواختی و پیوستگی سطح افزایش می‌یابد که این ویژگی می‌تواند بازتاب از سطح را افزایش داده و در نتیجه موجب کاهش میزان جذب گردد. همچنین افزایش اندازه بلورک‌ها که با افزایش مقدار برم در نمونه‌ها مشاهده شد (جدول ۱)، منجر به کاهش نقص‌های شبکه‌ای و مراکز به تله اندازه‌دهنده که باعث بازترکیب حامل‌های بار می‌شوند، می‌شود. همچنین کاهش نقص‌های شبکه‌ای باعث کاهش پراکندگی و جذب بیشتر فوتون‌های فرودی و تولید حامل‌های بار بیشتر می‌گردد [۳۱، ۳۲].

به منظور بررسی ویژگی‌های فوتولتایی سلول‌های خورشیدی ساخته‌شده با استفاده از لایه‌های جاذب سنتز شده (نمونه‌های S1 تا S5)، نمودارهای مشخصه چگالی جریان-ولتاژ آنها اندازه‌گیری شد که در شکل ۸ نشان داده شده‌اند. پارامترهای فوتولتایی به دست آمده از بررسی این نمودارها در جدول ۲ گزارش شده است. چنانکه دیده می‌شود، با افزایش غلظت مولی برم در سیستم، ولتاژ مدار باز (V_{oc}) سلول افزایش یافته است، زیرا چنانکه پیشتر اشاره شد با افزایش مقدار برم در لایه جاذب پروسکایتی، گاف انرژی افزایش یافته و بنابراین مقدار ولتاژ مدار باز سلول افزایش می‌یابد [۲۹، ۳۰]. با افزایش گاف انرژی، بخشی از طیف خورشید که در گستره انرژی‌های کمتر از انرژی گاف نواری پروسکایت است، جذب نشده و بنابراین الکترون و حفره کمتری تولید شده و چگالی جریان اتصال کوتاه (J_{sc}) کاهش می‌یابد. مقایسه نتایج

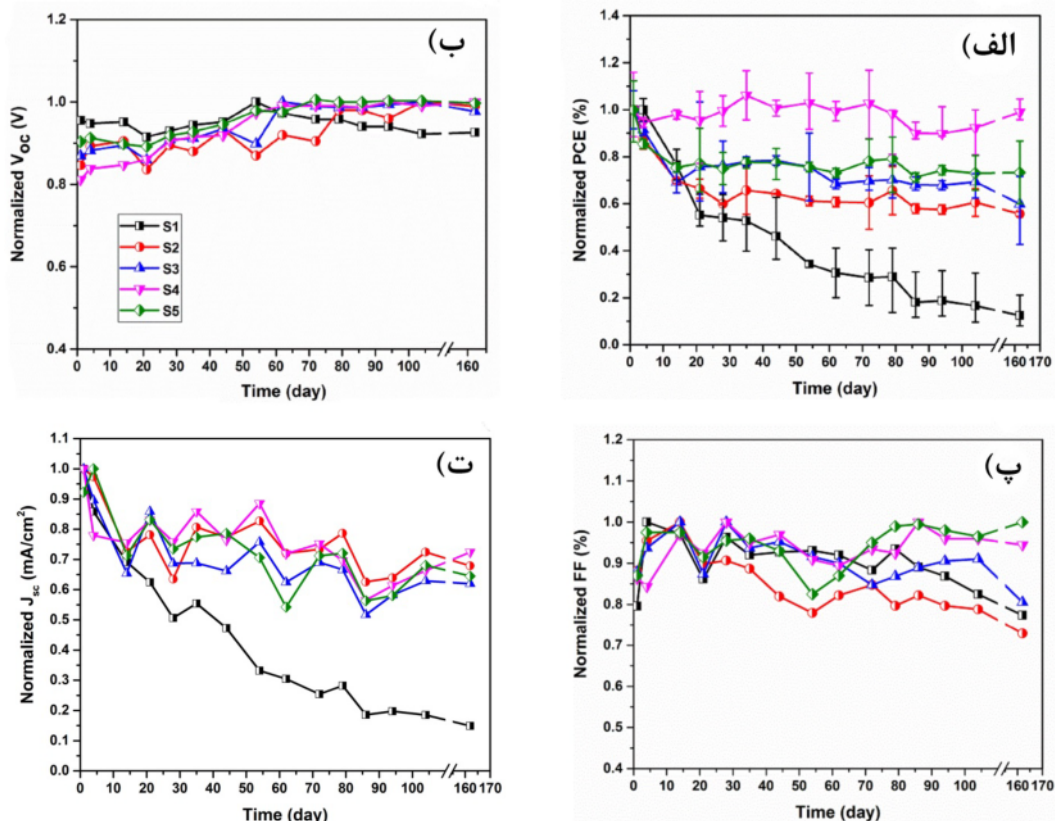


شکل ۸ منحنی‌های چگالی جریان-ولتاژ اندازه‌گیری شده برای سلول‌های خورشیدی ساخته‌شده با لایه‌های جاذب S1، S2، S3، S4، S5.

پایداری سلول شده‌اند. همچنین افزایش مقدار برم در لایه جاذب پروسکایتی تا نسبت مولی برم به ید ۱:۱ منجر به افزایش پایداری سلول خورشیدی در محیط آزاد شده است. مقادیر افت بازده سلول‌ها اندازه‌گیری شده پس از ۱۶۲ روز از ساخت سلول‌ها در جدول شماره ۲ گزارش شده است. بررسی ولتاژ مدار باز سلول‌ها نشان می‌دهد که در این مدت، مقادیر V_{oc} سلول‌ها تغییر قابل‌توجهی نداشته‌اند (شکل ۹ ب). در این مدت، مقادیر FF سلول‌های دارای لایه‌های جاذب S2 و S3 به ترتیب ۱۷٪ و ۱۲٪ کاهش و برای سلول‌های دارای لایه‌های جاذب S4 و S5 به ترتیب ۲۳٪ و ۱۶٪ افزایش داشته‌اند (شکل ۹ پ). همچنین مقادیر J_{sc} برای سلول‌های شامل لایه‌های جاذب S1، S2، S3، S4 و S5 به ترتیب ۸۵٪، ۳۲٪، ۳۸٪، ۲۸٪ و ۳۰٪ کاهش داشته‌اند (شکل ۹ ت). به‌طورکلی این بررسی نشان می‌دهد که پایداری بازده سلول خورشیدی دربردارنده لایه جاذب S4 (با نسبت مولی برم به ید ۱:۱) با بازده ۹٪ و افت ۱٪ در بیش از ۵ ماه از سایر سلول‌های ساخته‌شده بیشتر است.

که در این رابطه V_{max} و I_{max} به ترتیب بیشینه ولتاژ و چگالی جریان سلول و P_{in} توان نور فرودی است که مقدار آن 100 mW/cm^2 بود. مقادیر PCE به‌دست‌آمده در جدول ۲ گزارش شده است. مقایسه نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که بیشترین بازده (۱۱/۶۵٪) مربوط به سلول ساخته‌شده با لایه S1 (نمونه بدون برم) و کمترین مقدار آن (۷/۷۶٪) نیز مربوط به سلول ساخته‌شده با لایه S5 (نمونه دارای بیشترین غلظت مولی برم) است. کاهش/افزایش قابل‌توجه چگالی جریان در سلول خورشیدی دربردارنده لایه پروسکایت با بیشترین/کمترین (صفر) مقدار برم منجر به کاهش/افزایش بازده تبدیل انرژی شده است.

در شکل ۹ نمودارهای تغییرات زمانی PCE ، V_{oc} ، J_{sc} و FF در مدت ۱۶۲ روز پس از تولید سلول‌ها نشان داده شده است. چنان که در شکل ۹ الف دیده می‌شود بیشترین (۸۶٪) و کمترین (۱٪) مقدار افت بازده به ترتیب مربوط به سلول‌های دربردارنده لایه‌های جاذب S1 (بدون برم) و S4 (با نسبت مولی برم به ید ۱:۱) است. نمودارهای پایداری PCE نشان می‌دهند که به‌طورکلی لایه‌های جاذب آلاییده با برم باعث افزایش



شکل ۹ نمودارهای پایداری الف- PCE ب- V_{oc} پ- FF و ت- J_{sc} برحسب زمان (روز) برای سلول‌های خورشیدی ساخته‌شده با لایه‌های جاذب مختلف.

افزایش آن، گاف نواری آن‌ها از مقدار 1.556 eV برای نمونه بدون برم به مقدار 2.290 eV برای نمونه بدون ید افزایش می‌یابد. بیشترین و کمترین میزان جذب به ترتیب برای لایه‌های بدون برم و بدون ید دیده شد. بررسی مشخصه‌های فوتولتایی سلول‌های ساخته‌شده با استفاده از لایه‌های جذب پروسکایتی نشان داد که سلول‌های ساخته‌شده دربردارنده لایه‌های پروسکایت آلاییده با برم در گستره زمانی ۱۶۲ روز دارای پایداری بهتری هستند. سلول شامل لایه جذب پروسکایتی با نسبت مولی برم به ید برابر با ۱:۱ با دارا بودن بازده ۹٪ دارای بیشترین پایداری بازده بوده و اتلاف بازده تبدیل انرژی این سلول در بیش از ۵ ماه (۱۶۲ روز) تنها ۱٪ است. بیشترین بازده تبدیل انرژی (۱۱.۶۵٪) مربوط به سلول دربردارنده لایه جذب بدون آلایش برم بود، در حالی که بازده این سلول از پایداری مناسبی برخوردار نبود (۸۶٪ اتلاف بازده در ۱۶۲ روز).

قدردانی

نویسندگان از حمایت مالی دانشگاه شاهرود و همچنین خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاه نانوایپتوالکترونیک (NOPL) دانشگاه تربیت مدرس تقدیر و تشکر می‌نمایند. همچنین نویسندگان از سرکار خانم دکتر عرب‌پور بابت نقطه نظرات ارزشمندشان و از جناب آقای مهندس شکرالله‌زاده بابت همکاری در انجام بررسی‌های AFM کمال تشکر را دارند.

مراجع

- [1] Stoumpos C.C., Malliakas C.D., Kanatzidis M.G., "Semiconducting tin and lead iodide perovskites with organic cations: phase transitions, high mobilities, and near-infrared photoluminescent properties", *Inorganic chemistry* 52 (2013) 9019-9038.
- [2] Cao K., Li H., Liu S., Cui J., Shen Y., Yang m., "MAPbI_{3-x}Br_x mixed halide perovskites for fully printable mesoscopic solar cells with enhanced efficiency and less hysteresis", *Nanoscale* 8 (2016) 8839-8846.
- [3] Kim H.S., Park N.G., "Parameters affecting I-V hysteresis of CH₃NH₃PbI₃ perovskite solar cells: effects of perovskite crystal size and mesoporous TiO₂ layer", *The journal of physical chemistry letters* 5 (2014) 2927-2934.
- [4] Eperon G.E., Burlakov V.M., Docampo P., Goriely A., Snaith H.J., "Morphological control for high performance, solution-processed planar

توضیح علت پایداری سلول خورشیدی ساخته‌شده با استفاده از لایه‌های جذب آلاییده با برم می‌توان به دلایل مختلفی اشاره کرد در پایداری سلول خورشیدی دربردارنده لایه‌های جذب پروسکایتی آلاییده با برم، ممکن است به ساختار متراکم و یکنواخت‌تر لایه‌های جذب در حضور یون‌های برم مربوط باشد. با توجه به نتایج برآمده از بررسی تصاویر SEM و AFM حضور و افزایش مقدار برم در لایه‌های پروسکایتی می‌تواند سطح تماس لایه انتقال‌دهنده حفره (P3HT) و لایه جذب در سلول خورشیدی را افزایش داده باشد. بنابراین پوشش بهتر فصل مشترک لایه پروسکایت با لایه P3HT مانع تماس لایه جذب پروسکایتی با جو پیرامون آن شده و در نتیجه این عامل نیز ممکن است به افزایش پایداری سلول کمک کرده باشد.

از سوی دیگر، افزایش پایداری سلول‌های خورشیدی ممکن است در اثر جا نشانی اتم‌های کوچک‌تر Br⁻ به جای اتم‌های بزرگ‌تر I⁻ در ساختار بلوری پروسکایت آلاییده با برم و در نتیجه کاهش ثابت شبکه و گذار از فاز چارگوشی به فاز مکعبی رخ داده باشد [۲۰]. همچنین برهم‌کنش قوی‌تر بین Br⁻ و CH₃NH₃⁺ نیز می‌تواند منجر به افزایش پایداری لایه‌های پروسکایتی شده باشد [۳۴].

برداشت

در این پژوهش، نخست لایه‌های جذب پروسکایتی خالص CH₃NH₃PbI₃ و آلاییده با برم با نسبت‌های مولی برم به ید متفاوت (۱:۰، ۱:۱، ۱:۲، ۱:۳، ۱:۴، ۱:۵) به روش دومرحله‌ای چرخشی- چرخشی تهیه شدند. سپس تأثیر آلایش برم بر ویژگی‌های ساختاری و نوری این لایه‌ها بررسی شد. بررسی مشخصه‌های ساختاری این لایه‌های جذب نشان داد که حضور و افزایش برم از نسبت‌های مولی برم به ید ۳:۱ به بعد باعث تغییر ساختار پروسکایتی لایه‌ها از فاز چارگوشی به فاز مکعبی می‌شود. بررسی تصاویر SEM نشان داد که با حضور برم، لایه‌ها متراکم‌تر شده و دانه‌بندی آن‌ها به‌طور کلی تغییر می‌کند. با افزایش مقدار برم در لایه‌ها به تدریج اندازه دانه‌ها کوچک‌تر شده و در هم فرو رفتگی آن‌ها بیشتر می‌شود. بررسی تصاویر AFM نشان داد که با افزایش مقدار برم از زبری سطح لایه‌های جذب کاسته می‌شود. سطح لایه جذب بدون برم دارای بیشترین زبری و سطح لایه بدون ید دارای کمترین زبری است. بررسی ویژگی‌های نوری لایه‌ها نشان داد که با حضور برم و

- [14] Niu G., Guo X., Wang L., "Review of recent progress in chemical stability of perovskite solar cells", *Journal of Materials Chemistry A* 3 (2015) 8970-8980.
- [15] Chen W., Wu Y., Yue Y., Liu J., Zhang W., Yang X., Chen H., Bi E., Ashraful I., Grätzel M., "Efficient and stable large-area perovskite solar cells with inorganic charge extraction layers", *Science* 350 (2015) 944-948.
- [16] Song J., Zheng E., Bian J., Wang X.F., Tian W., Sanehira Y., Miyasaka T., "Low-temperature SnO₂-based electron selective contact for efficient and stable perovskite solar cell", *Journal of Materials Chemistry A* 3 (2015) 10837-10844.
- [17] Kwon Y.S., Lim J., Yun H.J., Kim Y.H., Park T., "A diketopyrrolopyrrole-containing hole transporting conjugated polymer for use in efficient stable organic-inorganic hybrid solar cells based on a perovskite", *Energy & Environmental Science* 7 (2014) 1454-1460.
- [18] Tripathi N., Yanagida M., Shirai Y., Masuda T., Han L., Miyano K., "Hysteresis-free and highly stable perovskite solar cells produced via a chlorine-mediated interdiffusion method", *Journal of Materials Chemistry A* 3 (2015) 12081-12088.
- [19] Smith I.C., Hoke E.T., Solis-Ibarra D., McGehee M.D., Karunadasa H.I., "A layered hybrid perovskite solar-cell absorber with enhanced moisture stability", *Angewandte Chemie* 126 (2014) 14414-14417.
- [20] Noh J.H., Im S.H., Heo J.H., Mandal T.N., Seok S.I., "Chemical management for colorful, efficient, and stable inorganic-organic hybrid nanostructured solar cells", *Nano letters* 13 (2013) 1764-1769.
- [21] Hao F., Stoumpos C.C., Cao D.H., Chang R.P., Kanatzidis M.G., "Lead-free solid-state organic-inorganic halide perovskite solar cells", *Nature Photonics* 8 (2014) 489-494.
- [22] Saporov B., Hong F., Sun J.P., Hong H.S., Meng W., Cameron S., Hill I.G., Yan Y., Mitzi D.B., "Thin-film preparation and characterization of Cs₃Sb₂I₉: A lead-free layered perovskite semiconductor", *Chem. Mater* 27 (2015) 5622-5632.
- [23] Qiu J., Qiu Y., Yan K., Zhong M., Mu C., Yan H., Yang S., "All-solid-state hybrid solar cells based on a new organometal halide perovskite sensitizer and one-dimensional TiO₂ nanowire arrays", *Nanoscale* 5 (2013) 3245-3248.
- [24] Murali B., Dey S., Abdelhady A.L., Peng W., Alarousu E., Kirmani A.R., Cho N., Sarmah heterojunction perovskite solar cells", *Advanced Functional Materials* 24 (2014) 151-157.
- [5] Kiermasch D., Rieder p., Tvingstedt K., Baumann A., Dyakonov V., "Improved charge carrier lifetime in planar perovskite solar cells by bromine doping", *Scientific reports* 6 (2016) 39333.
- [6] Liu D., Kelly T.L., "Perovskite solar cells with a planar heterojunction structure prepared using room-temperature solution processing techniques" *Nature photonics* 8 (2014) 133-138.
- [7] Liu M., Johnston M.B., Snaith H.J., "Efficient planar heterojunction perovskite solar cells by vapour deposition", *Nature* 501 (2013) 395.
- [8] Pockett A., Eperon G.E., Peltola T., Snaith H.J., Walker A., Peter L.M., Cameron P.J., "Characterization of planar lead halide perovskite solar cells by impedance spectroscopy, open-circuit photovoltage decay, and intensity-modulated photovoltage/photocurrent spectroscopy" *The Journal of Physical Chemistry C* 119 (2015) 3456-3465.
- [9] Zhang T., Yang M., Zhao Y., Zhu K., "Controllable sequential deposition of planar CH₃NH₃PbI₃ perovskite films via adjustable volume expansion" *Nano letters* 15(2015) 3959-3963.
- [10] Abbas H.A., Kottokkaran R., Ganapathy B., Samiee M., Zhang L., Kitahara A., Noack M., Dalal V.L., "High efficiency sequentially vapor grown nip CH₃NH₃PbI₃ perovskite solar cells with undoped P3HT as p-type heterojunction layer", *APL Materials* 3 (2015) 016105.
- [11] Yaghoobi Nia N., Matteocci F., Cina L., Di Carlo A., "High Efficiency Perovskite Solar Cell Based on Poly (3-hexylthiophene)(P3HT): The Influence of P3HT Molecular Weight and Mesoscopic Scaffold Laye", *ChemSusChem* 10 (2017) 3854-3860.
- [12] Kojima A., Teshima K., Shirai Y., Miyasaka T., "Organometal halide perovskites as visible-light sensitizers for photovoltaic cells", *Journal of the American Chemical Society* 131(2009) 6050-6051.
- [13] Yang W.S., Park B.W., Jung E.H., Jeon N.J., Kim Y.C., Lee D.U., Shin S.S., Seo J., Kim E.K., Noh J.H., "Iodide management in formamidinium-lead-halide-based perovskite layers for efficient solar cells", *Science* 356 (2017) 1736-1739.

- CH₃NH₃PbI_{3-x}Br_x film for efficient perovskite solar cells exceeding 18%*", Scientific Reports 7 (2017) 44603.
- [30] Sutter-Fella C.M., Li Y., Amani M., Ager J.W., Toma F.M., Yablonovitch E., Sharp I.D., Javey A., "High photoluminescence quantum yield in band gap tunable bromide containing mixed halide perovskites", Nano Lett 16 (2016) 800-806.
- [31] Chen J., Shi T., Li X., Zhou B., Cao H., Wang Y., "Origin of the high performance of perovskite solar cells with large grains", Applied Physics Letters 108 (2016) 053302.
- [32] Ren X., Yang Z., Yang D., Zhang X., Cui D., Liu Y., Wei Q., Fan H., Liu S.F., "Modulating crystal grain size and optoelectronic properties of perovskite films for solar cells by reaction temperature", Nanoscale 8 (2016) 3816-3822.
- [33] Green M.A., "Solar cell fill factors: General graph and empirical expression", Solid-State Electronics 24 (1981) 788-789.
- [34] Jeon N.J., Noh J.H., Kim Y.C., Yang W.S., Ryu S., Seok S.I., "Solvent engineering for high-performance inorganic-organic hybrid perovskite solar cells", Nature materials 13 (2014) 897-903.
- S.P., Parida M.R., Saidaminov M.I., "Surface restructuring of hybrid perovskite crystals", ACS Energy Letters 1 (2016) 1119-1126.
- [25] Fedeli P., Gazza F., Calestani D., Ferro P., Besagni T., Zappettini A., Calestani G., Marchi E., Ceroni P., Mosca R., "Influence of the Synthetic Procedures on the Structural and Optical Properties of Mixed-Halide (Br, I) Perovskite Films", The Journal of Physical Chemistry C 119 (2015) 21304-21313.
- [26] Tauc J., Mentel A., "States in the gap", Journal of non-crystalline solids 8 (1972) 569-585.
- [27] Hoke E.T., Slotcavage D.J., Dohner E.R., Bowring A.R., Karunadasa H.R., McGehee M.D., "Reversible photo-induced trap formation in mixed-halide hybrid perovskites for photovoltaics", Chemical Science 6 (2015) 613-617.
- [28] Zhou Y., Zhou Z., Chen M., Zong Y., Huang J., Pang S., Padture N.P., "Doping and alloying for improved perovskite solar cells", Journal of Materials Chemistry A 4 (2016) 17623-17635.
- [29] Tu Y., Wu J., Lan Z., He X., Dong J., Jia J., Guo P., Lin J., Huang M., Huang Y., "Modulated